ST02-27G1

27V 200W

特 長

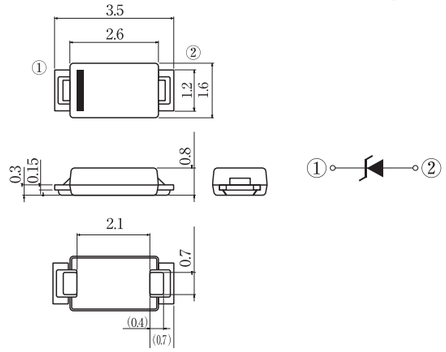
・1Wクラス
・小型SMD
・車載用途も対応可能

Feature

・1W Class
・Small SMD
・Available for automotive use

■外観図 OUTLINE

Package : G1F
Unit:mm
Weight 0.011g



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking,Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

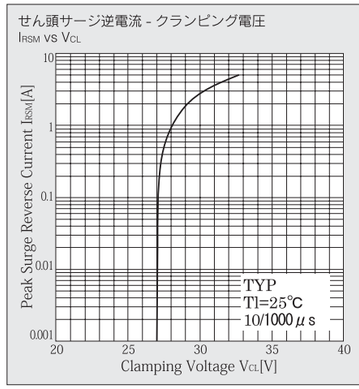
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings(指定のない場合 T_l=25℃／unless otherwise specified)

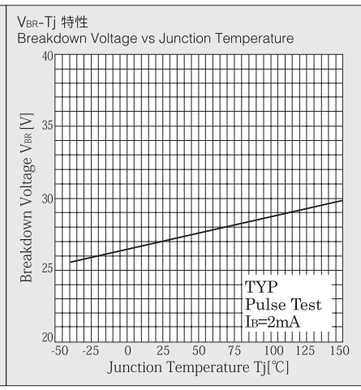
項 目 Item	記号 Symbol	条 件 Conditions	規定値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage temperature	T_{stg}		-55～150	℃
接合部温度 Operating junction temperature	Tj		150	℃
せん頭サージ逆電流 Maximum surge reverse current	I_{RSM}	10/1000μs 非繰り返し 10/1000μs Non-repetitive	5.5	A
せん頭サージ逆電力 Maximum surge reverse power	P_{RSM}	10/1000μs 非繰り返し 10/1000μs Non-repetitive	200	W
許容損失 Power Dissipation	P		1	W
連続印加電圧 Maximum reverse voltage	V_{RM}		23	V

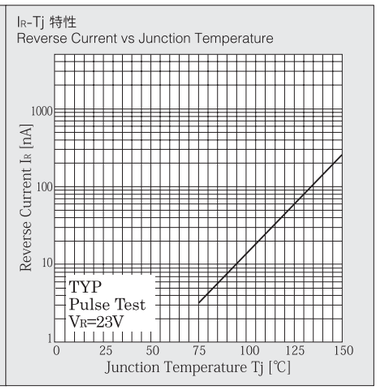
●電気的・熱的特性 Electical Characteristics(指定のない場合 T_l=25℃／unless otherwise specified)

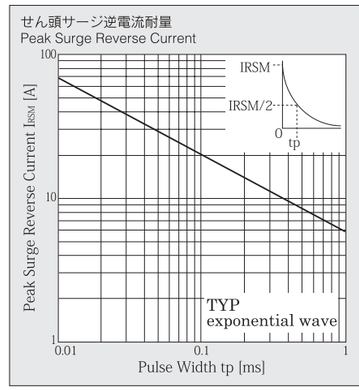
動作開始電圧 Breakdown voltage	V_{BR}	I_R=2mA	MIN. 25.1 TYP. 27.0 MAX. 28.9	V
制限電圧 Restriction voltage	V_{CL}	10/1000μs I_{pp}=5.5A	MAX. 37.0	V
逆電流 Reverse current	I_R	V_R=23V, パルス測定 V_R=23V, Pulse measurement	MAX. 5.0	μA
熱抵抗 Thermal resistance	θjl	接合部・リード間 プリント基板実装 junction to lead On glass-epoxy substrate	MAX. 20	℃/W
	θja	接合部・周囲間 プリント基板実装 160mm² junction to ambient On glass-epoxy substrate 160mm²	MAX. 120	

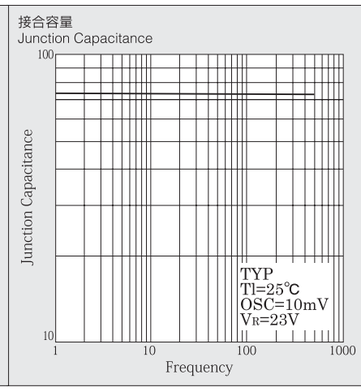
■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

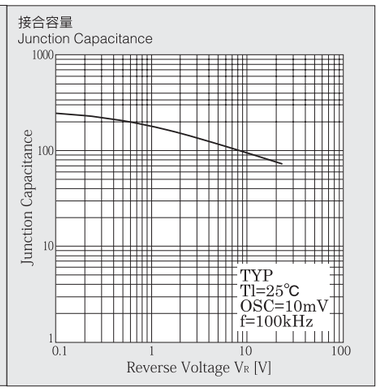












＊Sine waveは50Hzで測定しています。
＊50Hz sine wave is used for measurements.
＊半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
Typicalは統計的な実力を表しています。
＊Semiconductor products generally have characterristic variation.
Typical a statistical average of the devices ability.